

ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИЗИКОВ ИМЕНИ Н.Г. БАСОВА НИЯУ «МИФИ-ФИАН»

Высшая школа физиков (ВШФ НИЯУ «МИФИ-ФИАН») — специальный факультет физики МИФИ — была основана в 1971 г. тремя выдающимися учеными, выпускниками МИФИ — лауреатом Нобелевской премии академиком Н.Г. Басовым и профессорами В.Г. Кирилловым-Урюмовым и Ю.А. Быковским. Научным руководителем Школы является д.ф.-м.н., зам.директора Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, директор Отделения квантовой радиофизики ФИАН академик РАН О.Н. Крохин.

В Высшую школу физиков на основе индивидуального конкурсного отбора, в порядке перевода, зачисляются студенты из различных вузов страны (как правило, университетов), имеющие образование в объеме *двух с половиной курсов* физических факультетов, проявившие склонность и способность к научно-исследовательской инженерной работе. Получив диплом НИЯУ «МИФИ», выпускники направляются в распоряжение вузов, откомандированных на обучение. При этом значительная часть выпускников продолжает обучение в целевой аспирантуре (а в дальнейшем и в докторантуре) НИЯУ «МИФИ», ФИАН, а часто и за границей в ведущих вузах США и др.

Каждый год Высшая школа физиков НИЯУ «МИФИ-ФИАН» с 1 октября объявляет конкурс по приему студентов на шесть семестров обучения на целевую (контрактную) подготовку за счет средств бюджета по договорам с вузами. За все это время к февралю 2010 года проведено 39 наборов и 36 выпускников студентов. Через систему ВШФ прошло более 1000 человек — представителей более 75 вузов России и ближнего зарубежья. Значительная часть из них имеет теперь ученые степени.

Обучение ведется по следующим специальностям:

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА — физика твердого тела и фотоника: твердотельные лазеры и взаимодействие электромагнитного излучения с веществом и биологическими объектами; интегральная оптика; ядерно-физические методы исследования конденсированных сред; лазерные методы экологического контроля; лазерная физика; технологические применения лазеров; физика полупроводников и наноструктур, физика сверхпроводимости и сверхтекучести, квантовые вычисления, магнитные системы, фазовые переходы.

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЧАСТИЦ — космо- и астрофизика, конструирование и эксплуатация физических приборов и установок, ядерные методы нейтральных исследований, физика плазмы и плазменные технологии, математическое моделирование физических процессов, радиационная безопасность человека и охрана окру-

жающей среды, управляемый ядерный синтез, взаимодействие плазмы с поверхностью.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

— моделирование квантовых и классических мезоскопических систем, наноструктурированных поверхностей, слоистых наноматериалов (квантовых ям, систем наноточек, высокотемпературных сверхпроводников, фуллеренов и нанотрубок, атомных кластеров).

Обучение может проводиться по индивидуальным планам и осуществляется как на базе НИЯУ «МИФИ», так и на базе других учебно-научных центров (ФИАН, ОИЯИ г.Дубна, Курчатовский институт). Срок обучения на факультете 3 года. Предусмотрена усиленная языковая подготовка, обеспечивающая свободное владение английским языком. В ближайшем будущем планируется переход на двухуровневый стандарт образования «бакалавр-магистр».

Преподавательский состав традиционно состоит из преподавателей НИЯУ «МИФИ» и ведущих научных сотрудников ФИАН. Учебный процесс сочетает физико-математическую подготовку в объеме университетской программы, специальную подготовку по индивидуальному плану и научно-исследовательскую работу, которую студенты проводят как в лабораториях НИЯУ «МИФИ», так и в научных центрах ФИАН, Курчатовского центра, в ОИЯИ г.Дубна и других ведущих институтах и центрах Российской академии наук.

Студенты, зачисленные в ВШФ, пользуются всеми правами студентов НИЯУ «МИФИ». В соответствии с действующим законодательством студентам, обучающимся на бюджетной основе, выплачивается стипендия. Иногородные обеспечиваются общежитием.

Выпускники ВШФ НИЯУ «МИФИ» работают в научных центрах и университетах ведущих научных держав мира — США, Франции, Германии, Японии, Канады и др.

Наш адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31, НИЯУ «МИФИ». Высшая школа физиков НИЯУ «МИФИ-ФИАН». Телефон и факс: 8-499-725-24-06, телефон: (495)323-90-19. E-mail: hsph@mephi.ru.



В.А. Кашурников, заместитель декана ВШФ НИЯУ «МИФИ-ФИАН».

В.А. Кашурников, заместитель декана ВШФ НИЯУ «МИФИ-ФИАН».

ВЫСШИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Высший физический колледж Российской академии наук и Федерального агентства по образованию создан в МИФИ в 1991 г. с целью совершенствования высшего физического образования, обеспечения дополнительных условий для развития творческих способностей одаренных студентов и подготовки их для учебы в аспирантуре и последующей научной работы в научно-исследовательских институтах Академии наук и в международных научных центрах.

В состав Попечительского совета колледжа входят академики Е.П. Велихов, Ю.В. Гуляев, И.А. Щербаков, член-корреспондент РАН М.В. Ковальчук — директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», ученый секретарь Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте РФ.

По решению Попечительского совета колледж готовит специалистов в области физики наноструктур и нанотехнологий, физики сверхпроводимости, лазерной физики, взаимодействия концентрированных потоков излучения с веществом, физики, неравновесных твердотельных структур, микро- и нанозлектроники, физики плазмы, микро- и космофизики, релятивистской ядерной физики и по другим приоритетным направлениям физики.

Выбранные направления обеспечивают возможность подготовки специалистов на стыке наук и предусматривают одновременное взаимодействие нескольких выпускающих кафедр и академических институтов.

Обучение ведется по сложным программам изучения фундаментальных наук — на младших курсах и по индивидуальным планам — на старших. Кроме глубокой подготовки в области физики, математики, теоретической физики большое внимание уделяется компьютерной подготовке, изучению языков и гуманитарным наукам. Традиционно более трети выпускников заканчивают институт с отличием.

Выпускники колледжа отличаются высоким уровнем фундаментальных знаний в математике и физике, а также умением использовать современные наукоемкие и информационные технологии как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. Колледж имеет свой компьютерный класс, в котором не только проводятся занятия по компьютерному моделированию физических процессов, численным методам в математике и физике, машинной графике, но и предоставляется свободный доступ для работы студентов в сети Интернет во внеучебное время.

Учебно-научной базой колледжа является учебно-научная база НИЯУ «МИФИ», а также научных лабораторий академических институтов и НИЦ «Курчатовский институт».

Выпуск специалистов в рамках Высшего физического колледжа осуществляется выпускающими кафедрами: компьютерного моделирования и физики наноструктур и сверхпроводников (заведующий кафедрой — ректор НИЯУ «МИФИ», д.ф.-м.н., профессор М.Н. Стриханов), физики твердого тела и наносистем (заведующий кафедрой — д.ф.-м.н., профессор А.П. Менушков), лазерной физики

(заведующий кафедрой — д.ф.-м.н., профессор Н.Н. Евтихи-ев), микро- и нанозлектроники (заведующий кафедрой — д.ф.-м.н., профессор В.С. Першенков), физики плазмы (заведующий кафедрой — д.ф.-м.н., профессор В.А. Курнаев), экспериментальной ядерной физики и космофизики (заведующий кафедрой — д.ф.-м.н., профессор В.В. Дмитриенко).



Начиная с третьего курса студенты колледжа занимаются учебно-исследовательской работой, проходят преддипломную практику и дипломное проектирование на базе научных лабораторий институтов — попечителей колледжа: НИЦ «Курчатовский институт», Института общей физики РАН, Физического института РАН, Института радиотехники и электроники РАН, Института кристаллографии РАН, Института физики твердого тела РАН, Физико-технологического института РАН.

Профессора, преподаватели, аспиранты и студенты выполняют совместные научные исследования с рядом зарубежных научных центров и университетов, среди которых Университет г. Гренобля (Франция), Национальный синхротронный центр MAX-lab (Швеция), Научный центр DESY (Германия), Институт Макса Планка (Германия), Университет г. Осло (Норвегия) и др. Многие студенты и выпускники колледжа проходят научную стажировку и с успехом работают в научных центрах и университетах США, Германии, Франции, Англии, Швеции, Италии и Японии.

Выпускники колледжа получают диплом НИЯУ «МИФИ» и продолжают учебу в аспирантуре НИЯУ «МИФИ» и академических институтов или научную работу в международных научных центрах.

Набор в Высший физический колледж осуществляется в два этапа:

● **на первый курс** — из выпускников физико-математических лицей МИФИ №1511, №1523, №1547, школы №978 и подготовительного факультета на конкурсной основе;

● **на второй курс** — из студентов всех дневных факультетов НИЯУ «МИФИ» после окончания первого курса на конкурсной основе.

Дорогие абитуриенты! Система обучения в Высшем физическом колледже НИЯУ «МИФИ» позволит развить ваши способности и реализовать ваши творческие возможности. Не упустите свой шанс.

А.П. Менушков, декан Высшего физического колледжа, доктор физико-математических наук, профессор.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Основная задача подготовительного факультета — повышение уровня подготовки будущих студентов НИЯУ «МИФИ» и создание для них условий для поступления и обучения в университете.

Структура факультета позволяет реализовать подготовку учащейся молодежи по различным формам, учитывая склонности и возможности потенциальных абитуриентов. Одновременно решается задача подготовки к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и к участию абитуриентов в предметных олимпиадах.

Дневная очная подготовка реализуется на базе государственных общеобразовательных учебных заведений — лицеев при МИФИ (№1511, №1523 и №1547) и школы №978, в которых обучаются школьники 8–11-х классов по различным образовательным программам повышенного уровня подготовки.

Конкурсный отбор учащихся на физико-математическое направление подготовки этих учебных заведений проводится ежегодно в феврале-марте в 9-е и 10-е классы и в апреле-мае в 8-е классы.

По гуманитарному направлению подготовки отбор учащихся в 8-е и 10-е классы проводится в мае.

Занятия по профильным дисциплинам в этих учебных заведениях ведут высокопрофессиональные учителя и преподаватели университета. Выпускники этих учебных заведений получают полное среднее образование и успешно обучаются в НИЯУ «МИФИ».

Вечерняя очная подготовка предлагает учащимся 28 различных образовательных программ в форме подготовительных курсов.

По физико-математическому и гуманитарному направлениям, включая изучение отдельных дисциплин для подготовки к сдаче

ЕГЭ, обучение осуществляется на базе лицеев (для учащихся 7–9-х классов), на базе университета и школы №978 при МИФИ (для учащихся 10–11-х классов, учащихся колледжей и техникумов), а также на базе ряда школ Москвы и Московской области, имеющих договоры о сотрудничестве с университетом.

Для учащихся отдаленных районов Московской области организованы субботние и воскресные лектории.

Занятия проводятся по расписанию по утвержденным программам.

Прием заявлений на обучение по различным программам подготовки производится непрерывно с сентября по март. Обучение платное.

Заочная подготовка предлагает московским и иногородним школьникам традиционные курсы по математике, физике, химии и русскому языку для учащихся 6–11-х классов, а также работающей молодежи. Учащиеся обеспечиваются необходимыми методическими материалами, задания выполняются дома, в удобное время.

Прием заявлений производится ежегодно с августа по ноябрь. Обучение платное.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.podfak.mephi.ru или по телефону: (495) 324-60-40.



Ю.В. Самоварщиков, декан подготовительного факультета, заслуженный учитель РФ.

ФАКУЛЬТЕТ ОЧНО-ЗАОЧНОГО (ВЕЧЕРНЕГО) ОБУЧЕНИЯ

Шестидесять один год в нашем вузе осуществляется подготовка специалистов для научных учреждений, производственных предприятий и других организаций различных форм собственности по очно-заочной (вечерней) форме обучения. Такое обучение дает возможность получения престижного образования по новейшим направлениям науки и техники без отрыва от производства, что особенно ценно в нынешних условиях.

Лица, зачисленные на специальности «Электроника и автоматика физических установок», «Физика конденсированного состояния вещества», «Ядерные реакторы и энергетические установки», имеют возможность в течение шести лет получить квалификацию инженера-физика. За время учебы студенты получают фундаментальную физико-математическую подготовку, компьютерное и инженерное образование, изучают широкий круг экономических дисциплин, специализируются в области новейших достижений экспериментальной физики. Полученные знания позволяют выпускникам факультета успешно работать как в избранных направлениях деятельности, так и в смежных областях науки и техники.

Выпускники техникумов и колледжей, получившие подготовку по вычислительной технике, автоматике, микроэлектронике и радиотехнике, зачисляются в группы с сокращенным сроком обучения (четыре года) при условии поступления на родственную специальность. По окончании обучения им присваивается квалификация инженера или инженера-физика.

Помимо бюджетного обучения на факультете имеется обучение на платной (контрактной) основе.

Выпускникам техникумов компьютерного профиля предлагается ускоренная подготовка (3,5 года) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Обучение будущих инженеров-системных специалистов организовано по специализации «Программное обеспечение вычислительных систем» как на бюджетной, так и на платной основе.

Для выпускников техникумов и колледжей экономико-информационной направленности организовано платное обучение в сокращенные сроки по специальности «Прикладная информатика в экономике» (специализация — «Информационный менеджмент», квалификация — информатик-экономист). Помимо базовой подготовки в области вычислительной техники и информационных технологий студенты изучают широкий круг дисциплин, связанных с маркетингом, менеджментом, рыночной экономикой и предприниматель-

ской деятельностью. В учебном процессе по этому направлению принимают участие ведущие специалисты крупных коммерческих фирм и организаций. Обучение выпускников средних школ и непрофильных техникумов по этой специальности осуществляется в течение пяти лет.

Факультет очно-заочного (вечернего) обучения совместно с факультетом информационной безопасности осуществляет подготовку специалистов по специальности «Комплексная защита объектов информатизации» на контрактной основе. Выпускники данной специальности получают квалификацию специалиста по защите информации, позволяющую проектировать, внедрять и эксплуатировать специальные технические и программно-математические средства защиты информации на различных объектах информатизации. В подготовке будущих специалистов помимо профессорско-преподавательских кадров университета принимают участие ведущие специалисты зарубежных и отечественных фирм и компаний, успешно работающих и зарекомендовавших себя на российском рынке информационных технологий. Продолжительность обучения — 5 лет.

На факультете возможно получение второго высшего образования по перечисленным специальностям и направлениям (сроки обучения: 2-3 года в зависимости от вида и уровня предыдущего образования).

Принимаются на факультет очно-заочного (вечернего) обучения лица со средним или среднетехническим образованием, проживающие в Москве или Московской области. Заявления принимаются в приемной комиссии института с 20 июня.

Дополнительные сведения о порядке приема на факультет очно-заочного (вечернего) обучения можно получить по телефонам: 324-71-04, 323-95-08.



Б.Ф. Ануфриев, декан факультета очно-заочного (вечернего) обучения.